

2SA807, 2SA808, 2SA808A

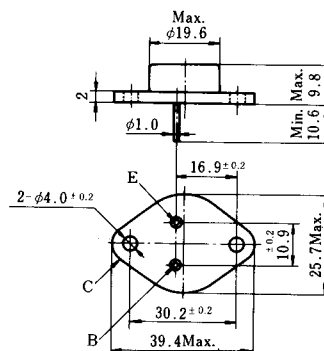
■シリコンPNPエビタキシャルメサ形トランジスタ

○一般用

■最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	記 号	2SA807	2SA808	2SA808A
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	-60V	-80V	-100V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	-60V	-80V	-100V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	-6V		
コレクタ電流	I_C	-6A		
ベース電流	I_B	-3A		
許容コレクタ損失	P_C	50W (フランジ温度 25°C)		
接合部温度	T_j	150 $^\circ\text{C}$		
保存温度	T_{stg}	-65 $\sim$ +150 $^\circ\text{C}$		

外形寸法 (単位: mm)
JEDEC(TO-3), EIAJ(TC-3, TB-3)



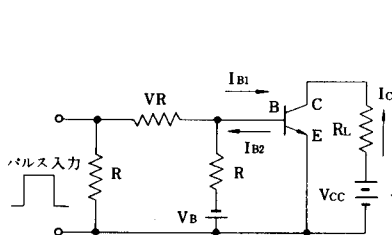
■電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	記 号	試 験 条 件	2SA807	2SA808	2SA808A
最大コレクタしゃ断電流	I_{CB0}		-1.0mA	-1.0mA	-1.0mA
		$V_{CB} =$	-60V	-80V	-100V
最大エミッタしゃ断電流	I_{EB0}	$V_{EB} = -6V$	-1.0mA		
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	$I_C = -50\text{mA}$	-60V	-80V	-100V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = -4V$ $I_C = -3A$	20Min.		
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -3A$ $I_B = -0.3A$	-1.5V Max.		
しゃ断周波数	f_T	$V_{CE} = -12V$ $I_E = 0.5A$	10MHz Typ.		

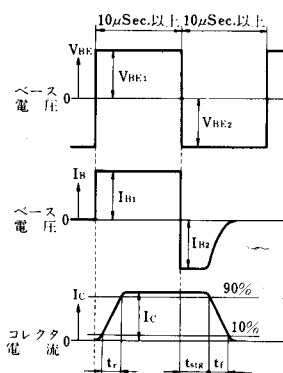
■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V_{CC} (V)	R_L (Ω)	I_C (A)	I_{B1} (mA)	I_{B2} (mA)	t_r ($\mu\text{Sec.}$)	t_{stg} ($\mu\text{Sec.}$)	t_f ($\mu\text{Sec.}$)
-10	3	-3	-300	50	1.2	1.8	0.3

スイッチング特性測定回路



測 定 条 件



周囲温度と最大許容損失

